(54) SWITCHING ELEMENT

(11) 1-103888 (A) (43) 20.4.1985 (J)

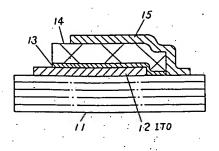
(21) Appl. No. 62-262140 (22) 16.10.1987

(71) MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD (72) MICHIHIRO MIYAUCHI(2)

(51) Int. Cl'. H01L45/00

PURPOSE: To make a switching element small in a leakage current and excellent in a non-linear property by a method wherein a silicon nitride thin film is utilized as an insulator layer and a hydrogen concentration contained in the silicon nitride film is made to be small near the interface between the film and a first electrode layer.

CONSTITUTION: Hydrogen concentration of a silicon nitride film 13 is made to be smaller than that of a silicon nitride film 14. And, the silicon nitride films are made not to contain an impurity such as oxygen, indium, or the like. That is, a first electrode of ITO(Indium Tin Oxide) is made not to be deoxided while the silicon nitride film 13 is formed and moreover the film 13 serves as a protective film for the first electrode of ITO during the formation of the silicon nitride film 14. As the silicon nitride film 13 is as thin as 100 Å or so, visual light rays can penetrate it without being absorbed. By these processes, a switching element which is almost transparent for visual light rays and excellent in a non-linear property can be easily formed without deoxidizing the first electrode of ITO.



11; insulating substrate, 15; second electrode

(54) GAS LASER GENERATING DEVICE

(11) 1-103889 (A) (43) 20.4.1989 (19) JP

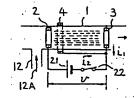
(21) Appl. No. 62-139787 (22) 5.6.1987

(71) HITACHI LTD (72) MINORU SUZUKI(1)

(51) Int. Cl. H01S3/03,H01S3/097

PURPOSE: To enable an electrical energy necessary for the laser oscillation to decrease by a method wherein an auxiliary electrode is provided to the outside of a discharge tube on one primary electrode side and the auxiliary electrode is connected to the same potential as the other primary electrode.

CONSTITUTION: One primary electrode 2 inside a discharge tube 1 and an auxiliary electrode 4 outside the discharge tube 1 are arranged facing toward each other, and the auxiliary electrode 4 is connected so as to be the same potential as the other primary electrode 3. As a discharge power source voltage V makes the voltage increase drastically before a glow discharge starts, the voltage change with time (dv/dt) is large, but once the discharge starts, the voltage becomes constant, which is a glow discharge voltage, so that dv/dt is made small. The auxiliary electrode 4 is separated from the primary electrodes 2 and 3 by the wall of the discharge tube 1 and the impedance between them is an electrostatic capacitance, wherefore an auxiliary current is supplied only when dv/dt is large. As mentioned above, an auxiliary current is made to flow between the primary electrodes 2 and 3 and the auxiliary electrode 4 when the discharge starts, so that a power consumption is decreased.



(54) SEMICONDUCTOR LASER DEVICE

(11) 1-103890 (A) (43) 20.4.1989 (19) JP

(21) Appl. No. 62-262123 (22) 16.10.1987

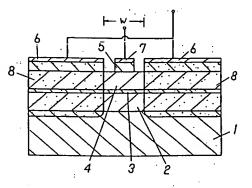
(71) MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD (72) ATSUYA YAMAMOTO(5)

(51) Int. Cl4. H01S3/18

PURPOSE: To prevent a laser from decreasing in an optical output and a light emitting efficiency by a method wherein a stripe-like multilayer thin film containing an active layer is formed on one primary face of a semi-insulating substrate and a thin film, whose conductivity type is the same as that of a clad layer comprised in the multilayer thin film, is formed adjacently to at least one side of the multilayer thin film.

CONSTITUTION: A laser device is constructed in such a manner that a multilayer thin film of double-hetero structure comprising a multiple quantum well layer as an active layer 3 is formed on a substrate 1 and a p-type region 8 is formed on the part of the substrate 1 other than a stripe-like laser region W in width so as to be contacted with the substrate 1, so that carriers are directly injected into the active layer 3 from the p-type region 8 and also through a p-type clad layer 2. Therefore, a series resistance of the active layer is not increase, conse-

quently heat release is restrained. In result, the decrease in and optical output and a light emitting efficiency are made difficult to occur.



⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平

平1-103889

@Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

母公開 平成1年(1989)4月20日

H 01 S

3/03 3/097 B-7630-5F A-7630-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 ガスレーザ発生装置

②特 頭 昭62-139787

❷出 顧 昭62(1987)6月5日

四発 明 者 鈴 木

実

茨城県日立市国分町1丁目1番1号 株式会社日立製作所

国分工場内

四発 明 者 杉 山

勤

茨城県日立市国分町1丁目1番1号 株式会社日立製作所

国分工場内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

邳代 理 人 弁理士 小川 勝男

外2名

明 細 君

1.発明の名称

ガスレーザ発生装置

- 2. 特許請求の範囲
- 3.発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、補助電極を改良したガスレーザ発生 装置に関する。

〔従来の技術〕

ガスレーザ発生装置の出力を増加させる目的で、 放電管内のガス圧を高くすることが行なわれる。 一方、ガス圧を上昇させると放電開始電圧が上昇する為、放電開始を円滑に行なわせるために、放電管内に補助電極を設置し外部より電圧を印加する方式が提案されている(例えば特開昭60 – 161687号)。

時間もの経過と共に一定になる。

(発明が解決しようとする問題点)

このように、従来例においては、放電管内に補助電極30を設置している為に放電が開始された後も、補助電極30でグロー放電が維持される為に、補助電液i2が流れ続け、この電流性を規制する抵抗器31が必要であり、抵抵器31の発熱で熱的な損失が発生する。又、補助電極30の疑惑を力による放電管内の汚損及び放電管内に補助電極30を設置する為に構造が複雑になる等の欠点を力していた。

ちなみに上記の抵抗における発生熱を概算すると、放電管を4本使用した500W級の発掘器においては、補助電極の電流規制抵抗は2MΩ程度となり、放電維持電圧が12kVであることより発生熱量は、288Wとなり、発掘出力の半分以上の熱が損失として放出されていることが解る。

本発明の目的は、放電開始時のみ主電極と補助 電極との間に補助電流を流すようにして、消費電力を低減したガスレーザ発生装置を提供すること

(3)

次に、スイツチ22をオンして、主電極2と3との間および主電極2と補助電極4との間に直流電源21の放電電源電圧Vを印加すると、第3回(A)、同図(B)には、第5回(A)、(B)と同様な放電電源電圧Vおよびグロー放電電流i、が流れるが、グロー放電開始時は、同図(C)に示す補助電流i2は放

にある。

(問題点を解決するための手段)

放電管内側と外側との一方の主電極と補助電極 とを対向して配置し、補助電極を他方の主電極と 同電位になるように接続する。

〔作用〕

グロー放電開始前の放電電源電圧 V は、充電電 E の最高値まで急激に電圧を上昇させるので、電 E の時間変化 (d v / d t) が大きいが、一旦放電を開始するとグロー放電の一定電圧値となる。 はなでは小さな値となる。補助電極と主電極の間は放電管の壁で仕切られており、この間のインスは静電容量であることにより、d v / d t が大きい時だけ補助電流が供給されるようにした。

(実施例)

以下、本発明の実施例を第1回に示し説明する。 第1回は、放電管1を2本直列に接続した例である。

供納管 1 2 より供給されたレーザガス 1 2 A は、(4)

他開始時に急激に流れるが、放電開始後は流れない。主電極2と補助電極4との間には放電管1の壁で仕切られており、こののインとは静電容量であることにより、はより、は野電をであることにより、が大きであることにより、が大きでは、補助電流12の大きい時だけ流れ、補助電流12の大きい時に流れない。補助電流12が小さい時は流れない。補助電流12が小さい時間では流れない。補助電流12が小さい時間では流れる。

[発明の効果]

この結果、本発明の実施例によれば、従来必要であった、補助電流制御用抵抗が不要となり、抵抗で発生していた熱損失の発生が無く、レーザ発振に必要な電力量の低減を酉ることができる。又、放電管外に補助電極を設置する為、電極の消耗等による発根器内の汚損及び、電極の交換が不要となり信頼性の向上する等の効果を得ることができる。

又、パルス放電により短時間で高パルスピーク

の発根を行なう場合は、短時間内に電流をレーザガスに供給する必要がある為、一般に放電電源の電源立上がり特性を速くするが、本発明は、この様な場合に更に急峻な電流供給が行なえる為、放電の立上がりが早くなり一層の効果を得ることができる。

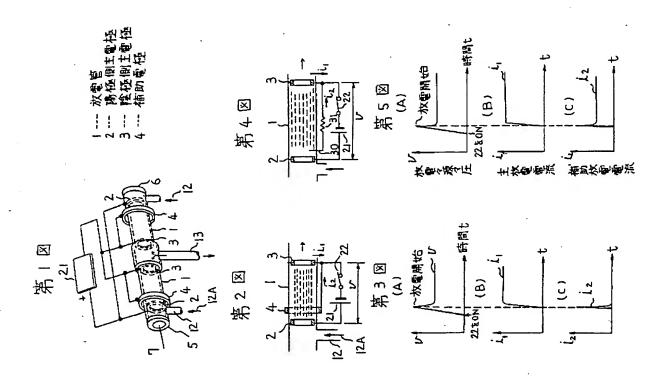
4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例であるガスレーザ発生 装置の概略斜視図、第2図は第1図の概略説明図、 第3図(A)ないし(B)は第1図、第2図の特 性図、第4図は従来のガスレーザ発生装置の概略 説明図、第5図(A)ないし(C)は第4図の特 性図である。

1 … 放電管、2 および3 … 陽極および陰極側の主 電極、4 … 補助電極。

代理人 弁理士 小川勝男

(7)



手 統 補 正 魯(方式)

의 63 = 11 1 4 H

特許庁 長 官 吉田 文 数 殿

事件の表示

昭 和 6 2 年 特許額 第 1 3 9 7 8 章 号

発 明 の 名 称 ガスレーザ発生装置

補正をする者

事件との関係 特許出願人

8 年(510) 林式会社 日 立 製 作 所

代 理 人

財 所(〒100) 東京都千代田区九の内一丁目5番1号

株式会社 日立製作所内 電話 東京212-1(11(大代表)

も (6850) 弁理士 小川 朋

補 正 の 対 象 明細客の図面の簡単な説明の欄

補正の内容

明細書第7頁第10行目の「B」特許戶

正する。

63.11.14

万式

京式 (